明石	工業高等	 専門学校	開講年度 令和06年		授業科目	電子回路特論			
科目基礎			·	•					
科目番号		6035		科目区分	専門/選	建択			
授業形態		講義		単位の種別と単位					
開設学科		機械・電子	<del></del>	対象学年	専2				
開設期		前期		週時間数	2				
教科書/教	材	指定しない	١						
担当教員		寺澤 真一							
到達目標	票								
本科目では や制御回路 子回路専門	は、VLSIデ 各への応用、 門分野でのi	バイスと回路 各種メモリL 果題と方策を理	設計、シミュレーションについ SIの特徴を学び、電子回路技術 理解することを目標とする。	て、講義及び演習形式で 前のロードマップを理解す	『授業を行う。CN する。さらに低消	IOS論理回路を正しく理解し、演算器 費電力化や信頼性技術など、近年の電			
ルーブリ	<u> </u>		T	T		T			
評価項目1			理想的な到達レベルの目安	標準的な到達レ		未到達レベルの目安			
			回路の設計と動作検証の技術を十   回路の設計と動作   分に理解できる。   解できる。		作検証の技術を理	回路の設計と動作検証の技術を理解できない。			
評価項目2			低消費電力化、高速化のため 術を十分に理解できる。		高速化のための技 ,				
評価項目3	3		SRAM, DRAM, FLASHなど高 メモリ回路技術を十分に理解 る。	高集積 Pでき メモリ回路技術を	FLASHなど高集積 を理解できる。	責 SRAM, DRAM, FLASHなど高集積 メモリ回路技術を理解できない。			
学科の予	達日樺Ti	頁目との関係		I					
教育方法		スロージスコ	<u>//\</u>						
概要	∆ <i>₹</i>	を遂げた。それを実現するための高性 近年の電子回路高性能設計を紹介し							
授業の進め	か方・方法	1) 回路の記 2) 低消費で 3) SRAM,	いて、講義形式と演習形式で授業を行う。試験は実施せず提出課題で評価を行う。 設計と動作検証の技術を理解する。 電力化、高速化のための技術を理解する。 DRAM, FLASHなど高集積メモリ回路技術を理解する。						
注意点		90時間に	授業で保証する学習時間と、 <sup>-</sup> 目当する学習内容である。 &としない欠席条件(割合) 1/3		ート作成に必要な	は標準的な自己学習時間の総計が、			
授業の属	属性・履修	多上の区分							
□ アクテ	-ィブラーニ	ング	☑ ICT 利用	☑ 遠隔授業対応	<u>,</u>	☑ 実務経験のある教員による授業			
授業計画	<u> </u>								
		週	受業内容	内容		標			
		1週	構義の概要とVLSI高性能化動向 電子回路特論の講義概要につい	て解説する。	講義の概要とVLSI高性能化動向 電子回路特論の講義概要について理解する。				
前期	1stQ	2週  r	IMOS/pMOSトランジスタとCI IMOS/pMOSトランジスタとCI こついて解説する。	MOSインバータ MOSインバータの動作	nMOS/pMOSトランジスタとCMOSインバータ nMOS/pMOSトランジスタとCMOSインバータの動作 について理解する。				
			CMOS論理回路 各種CMOS論理回路について解	説する。	CMOS論理回路 CMOS論理回路について理解する。				
		4週   (	CMOSを用いた組合せ回路 CMOS論理回路で構成する組合 る。	せ回路について解説す	CMOSを用いた組合せ回路 CMOS論理回路で構成する組合せ回路について理解する。。				
			CMOSを用いた順序回路 CMOS論理回路で構成する順序	回路について解説する	CMOSを用いた順序回路 CMOS論理回路で構成する順序回路について理解する。				
		6週	SIの製造工程 シリコン基板、ゲート酸化膜形 Oいて解説する。	成、イオン注入などに	LSIの製造工程 シリコン基板、ゲート酸化膜形成、イオン注入などに ついて理解する。				
		7週 L	/LSIの設計 .SI設計における機能設計、ハ- IIについて解説する。	- ドウェア記述言語と検	VLSIの設計 LSI設計における機能設計、ハードウェア記述言語と検 証について理解する。				
			軍発性メモリ回路 BRAMとDRAM回路構成と動作(	こついて解説する。	揮発性メモリ回路 SRAMとDRAM回路構成と動作について理解する。				
	2ndQ	9週 7	下揮発メモリ回路 下揮発メモリの回路構成と動作	について解説する。	不揮発メモリ回路 不揮発メモリの回路構成と動作について理解する。				
			Spiceを用いた回路設計演習1 Spiceによる回路入力について角	<b>解説する。</b>	Spiceを用いた回路設計演習 1 Spiceによる回路入力について理解する。				
		11週 5	piceを用いた回路設計演習 2 piceによる回路入力と動作検記		Spiceを用いた回路設計演習2 Spiceによる回路入力と動作検証について理解する。				
		12,65	piceを用いた回路設計 提出説 piceによる回路入力と動作検討	正について課題を解く。	Spiceを用いた回路設計 提出課題 1 Spiceによる回路入力と動作検証について課題を解く。				
		13週 5	Spiceを用いた回路設計 提出調	果題2 エニついて課題を解き場	Spiceを用いた回路設計 提出課題 2 Spiceによる回路入力と動作検証について課題を解く。				
		E	Spiceによる回路入力と動作検記 出する。	こことので素色で作るが	Spiceによる回路 テストと信頼性				

	15週 N	総まとめと今後の動 More than Moore、 /LSI技術の開発動作	まとめと今後の動向 ore than Moore、IoTセンサーノードなど今後の SI技術の開発動向を解説する。			総まとめと今後の動向 More than Moore、IoTセンサーノードなど今後の VLSI技術の開発動向を理解する。							
	16週	期末試験実施せず	施せず しょうしょ しょうしょ しょうしょ しょうしょ しょうしょ しょくしょ しょくしょく しょく										
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標													
分類	分野	学習内容	学習内容の到達目標				到達レベル	授業週					
評価割合													
	提出課題						合語	<b>;</b> †					
総合評価割合	100	0	0	0	0	0	10	0					
基礎的能力	0	0	0	0	0	0	0						
専門的能力	100	0	0	0	0	0	10	0					
分野横断的能力 0 0		0	0	0	0	0	0						